

力晶半導體股份有限公司 簡介

力晶半導體股份有限公司於 1994 年 12 月創立，業務範圍涵蓋動態隨機存取記憶體製造及晶圓代工兩大類別，目前為國內領先之全方位的記憶體公司，不僅擁有最先進製程技術，更具備世界級水準之產品良率及品質。力晶自成立以來，即以綠色企業為目標，並訂定節能減碳為全公司之環安衛政策，期能藉由節省能資源耗用以及溫室氣體排放減量管理等自願性減量作為，減緩因地球暖化效應所造成之環境衝擊，善盡企業的社會責任。

台灣半導體協會(TSIA)自 1998 年起即積極參與世界半導體協會(WSC)對 PFCs 減量的活動，其中力晶承諾將於 2010 年將 PFCs 排放量降至 115,000 公噸 CO₂ 當量以下，至 2007 年為止，力晶公司 PFCs 排放減量總計已達 790,000 公噸 CO₂ 當量，而 2007 年總排放量 116,674 公噸 CO₂ 當量，與 2010 年之承諾值也僅差距不到 2%，至 2010 年可符合 TSIA 對 WSC 之減量承諾(預期達成率 123%)。



『燃燒式局部尾氣處理設備』



此設備主要以天然氣為燃料與空氣及純氧混合進入燃燒室對製程尾氣進行高溫燃燒處理(燃燒室溫度 $>1200^{\circ}\text{C}$)，主要使用在薄膜製程針對溫室氣體 NF_3 及 CF_4 進行處理，去除效率可達99%以上。

『電熱式局部尾氣處理設備』



製程尾氣與廠內所提供之乾燥空氣混合後，進入利用加熱器加熱之電熱腔中(電熱腔溫度 $>850^{\circ}\text{C}$)進行高溫氧化或還原反應，主要使用在薄膜製程針對溫室氣體 NF_3 進行處理，去除效率可達95%以上。

『電熱觸媒式局部尾氣處理設備』



製程尾氣與廠內所提供之乾燥空氣混合後，進入以加熱器加熱之觸媒中(藉由觸媒可降低化學反應所需之活化能特性，觸媒溫度僅須維持在 $600-650^{\circ}\text{C}$)進行高溫氧化或還原反應，主要使用在蝕刻製程針對溫室氣體 CF_4 、 C_4F_8 、 CHF_3 及 SF_6 進行處理，去除效率可達99%以上。

『電漿式局部尾氣處理設備』



此設備係利用電漿作用將反應腔內的製程尾氣解離破壞，主要使用在蝕刻製程針對溫室氣體 CF_4 及 C_4F_8 進行處理，去除效率可達99%以上。

直燃式焚化爐(TO)



蓄熱式焚化爐(RTO)



採用平均熱回收效率可達90%以上的蓄熱式焚化爐(RTO)取代既有熱回收效率約40-60%的直燃式焚化爐(TO)，可有效節省燃料費的操作成本，並減少溫室氣體的排放。

功因改善盤內部



功因補償後功率因素錶



設備端設置低壓功因改善盤，可有效節省電力耗用。

